



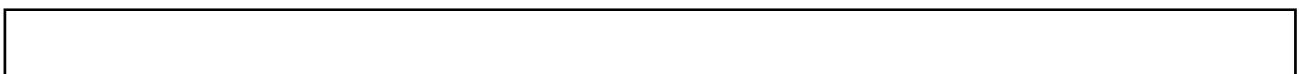
---

---

---

---

---



### Three Stages of Controlled Rolling

田 中 智 夫\*

Tomoo Tanaka

波戸村 太根生\*\*

Taneo Hatomura

田 畑 紹 久\*\*

Nobuhisa Tabata

#### Synopsis:

The controlled rolling consists of three stages: the first stage is for deformation in the range of

ほぼきまることになる。強度を仕上温度のパラメーターとして表わしたり、遷移温度を低温域での全圧下量のパラメーターとして整理する方法が用

第1段階についてであるが、高温域については加工によって再結晶が必ず起こるものと考えられている。しかし、加熱によって粗大化した $\gamma$ 粒（～

ところで、実験室的ないしは現場で行われるコントロールド・ローリングの低温域圧下は、ほぼ950～700°Cの温度範囲である。歪フリーの $\gamma$ が

圧下温度、圧下量、圧下前の結晶粒径、化学成分とくに再結晶遅効果の著しいNbの存在等の影響を受けるものと考らねられる。本研究では、高温域

$\alpha$ に変態する温度は700°C近辺であるから、950°～700°Cの温度範囲は $\gamma$ 域に属すると思われる。

しかし、変態前の $\gamma$ が歪め合す場合は変態がト

での圧下についてはとくに上記項目について調べた。第2段階(低温 $\gamma$ 域圧下)と第3段階(( $\gamma+\alpha$ )域圧下)の区分は最も困難な点であるのでおス

11/16/00 11:44:40 01111 1074

## 2.2 低温域圧下

$\gamma$ および $(\gamma+\alpha)$ 域圧下の影響を見るためには、 $Ar_3$ 温度を測定する必要がある。そのために以下

合組織は発達しない。したがって2パス圧下法から推定される変態点は歪誘起 $Ar_3$ である。

以上の2つの方法を用いて静的 $Ar_3$ と歪誘起 $Ar_3$ を求めた。いずれの場合も圧延終了時の板

し、 $1150^{\circ}\sim950^{\circ}\text{C}$ の温度範囲で3パス、50%の

はNb材のみである。

ナノ $\text{CrMnNb}$ の正規化と、 $1150^{\circ}\text{C}$

Separation



が存在する。この臨界圧下率  $R_{crit}$  は圧下温度の低下とともに高圧下率側に移行する。

Fig. 4 は SM 材、Nb 材の圧下温度と  $R_{crit}$  ある

る。析出処理によって固溶 Nb の一部が析出する。全 Nb 量は 350ppm であるが、 $1150^{\circ}\text{C}$  加熱時には 45ppm が析出 Nb となっている。30min

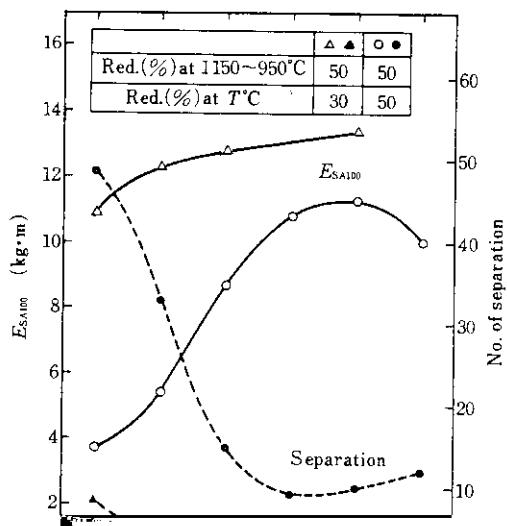
ある。SM 材では再結晶におよぼす初期粒径、圧下温度の影響は顕著ではない。それでも初期粒径が大きいと  $R_{exit}$  の増加すること、圧下温度の低



材と Nb 材の間に差がなく同一である。すなわち Nb の存在は再結晶速度に著しい影響を与えるが、再結晶した粒径に対する影響は僅少である。



Reduction (%)	Rolling temperature (°C)							
1150° 950°C	950° 650°C	650	700	750	800	850	900	



として、あるいは  $\gamma/\alpha$  境界層に沿って、あるいはマトリックス中に Nb, V の析出が急速に起こるものと考えられる。

#### 4. 検 計

##### 4.1 高温域圧下

950°C 以上の高温域での再結晶挙動に関するこれまでの研究は十分ではない。漠然とではあるが、再結晶が無条件に進行するものと考えられている。このことは Nb を含まない SM 材についてはだいたいにおいて正しい。しかし本実験が示す

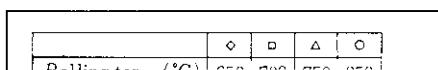
の時、粗大粒はほとんど生成しないが、圧下温度の低下とともに粗大粒生成のチャンスは増大の傾向を示す。これは圧下温度の低下とともに再結

セパレーション数は少なく、吸収エネルギーは高い。これに反して、 $(\gamma+\alpha)$  域圧下では降伏応力は高く、析出 Nb, V は多く、またセパレーショ

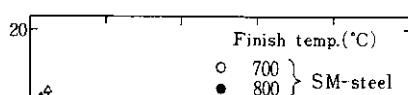
る (Fig. 4 参照)。

したがって、スラブの圧延においては10%/パス以上の圧下率での圧延が好ましい。最初の1, 2パスは特に留意して10%/パス以上を付与する

低温圧下が  $\gamma$  域から  $(\gamma+\alpha)$  域までまたがる場合、従来のように強度、非性を仕上温度、あるいは低溫域での全圧下量のパラメーターとして表現するのは正しい方法ではないことがわかる。以下では

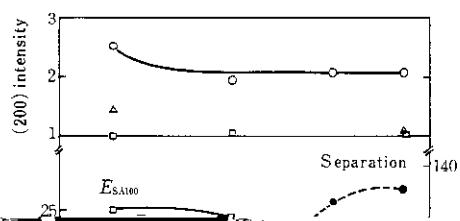


よる加工硬化も  $3 \text{ kg/mm}^2$  以下とすれば、残りは  
Nb, V の析出硬化  $\sigma_{ph}$  によるものであることにな



度が低温側に移行する理由についてはKazinczy<sup>8)</sup>, Kapadia<sup>9)</sup> および Knott<sup>10)</sup> の説明がある。

その画占は以下のようにある。 Fig. 15 に示す。



下を与える段階

第1段階はいわばコントロールド・ローリングのための準備段階であり、70%程度の圧下により~20 $\mu$ 程度の再結晶 $\gamma$ 粒が得られる。この段階ではこれ以上の圧下を付加しても~20 $\mu$ 以下の細粒を得ることは困難である。

起ころが 第4段階の圧下では、パルスヒート法による、高炉本体の温度上昇を抑制する方法

ない。

第3段階は  $(\gamma + \alpha)$  域圧下である。この段階で

は第2段階（ $\gamma + \alpha$ ）と同様に細粒化処理を実施す

るが、この段階では、高炉本体の温度上昇を抑制する方法

として、高炉本体の温度上昇を抑制する方法

效値に達する。この時点での粒径は $\sim 20\mu$ である。

吸エネルギー  $E_{SA100}$  は高い値を示す。

第3段階 ( $(\gamma+\alpha)$  域)

(viii) ( $\gamma+\alpha$ ) 壓下下により高い強度水準が得

(iv) 第1段階の上から直接アモルファスNbは再

粒径に対する影響は僅少である。

(v) 圧下率8%以下の軽圧下では歪誘起粒界

出硬化、特に後者が大きく寄与するためである（その他亜粒界による硬化も寄与している）